

第5回 物質科学談話会

日時:平成30年7月20日(金) 15:00~16:00

場所:ES総合館2階 ES022 講義室

講師:柴山 茂久(名古屋大学)

題目:High-k 薄膜材料の新規機能性

~HfO₂ 薄膜の強誘電性発現機構の理解~

内容: HfO₂ は Si CMOS において high-k 材料として用いられている. 近年, 第三元素を微量ドーブした HfO₂ 薄膜が強誘電性を示すことが発見されて以来, メモリ応用などに向けた研究が活発化している. 強誘電体 HfO₂ は材料科学的にも工業的にも極めて興味深い材料であるが, これを使いこなす上では, 強誘電性を発現させる外因的な条件ではなく, 真性的な強誘電性の発現機構の理解が必要である. 本講演では, HfO₂ 薄膜の強誘電性発現機構に関する現在の理解について紹介する.

問合せ:中塚 理

nakatuka@alice.xtal.nagoya-u.ac.jp